

**CSJM University Kanpur में B.Sc. Part 1 के Physics Subject में 3<sup>rd</sup> paper का title है circuit fundamental and basic electronics.**

आज हम **Electronics** में **semiconductors** पर चर्चा करेंगे।

**Conductivity** (चालकता) या **Resistivity** (प्रतिरोधकता) के आधार पर हम **solids** को **mainly** (मुख्यतः) तीन भागों में बांट सकते हैं— कुचालक अर्धचालक

**Conductors (Good Conductors** चालक

**Insulators (Bad Conductors** कुचालक

**Semiconductors** अर्धचालक

We know that metals like, Cu( ) And Al ( ) are good conductors for the flow of electric current

low Resistivity =  $10^{-6} \Omega\text{m}$

For insulators such as ceramic लकड़ी या plastic

Resistivity is very high. So that no electric current can

flow through them =  $10^{-10} \Omega\text{m}$

**Conductivity** Nil तीसरा material है **semiconductor** जैसा

कि इसके नाम से ही पता चलता है कि **semiconductor** की

**Resistivity** इन दोनों (C&I) के बीच की =  $10^{-1} \Omega\text{m}$  की

होती है **low temperature** पर एक **semiconductor** भी

**insulator** की तरह ही **behave** करता है। अर्थात् **low temperature** पर किसी **semiconductor** से **electric current flow** नहीं करता है।

**Semiconductors** से **related** यहां **2 important factors** है। पहला तो **Effect of temperature** and 2<sup>nd</sup> is **mixing of impurities**. किसी भी **Good conductors** की **resistivity** उसका **temperature** बढ़ने पर बढ़ जाती है ये किसी भी का **conductor** एक बड़ा **drawback** कि जबकि **Semiconductors** की प्रतिरोधता उसका **temperature** बढ़ने पर कम हो जाती है अर्थात् **low temp.** पर जो **Semiconductors** **insulator** की तरह **behave** करता है। वहीं **temp** बढ़ने पर उसकी **conductivity** उसकी चालकता बढ़ जाती है **so that we say that semiconductors have negative temp. co-efficient of resistance.**

इसी तरह जब किसी **metal** में कोई **impurity add** की जाये या किसी और **metal** को **mix** करके कोई **alloy** बनाया जाये तो उसकी **conductivity** में कोई **major changes**

नहीं आते है उसकी **physical properties change** हो सकती है, उसकी **strength** बढ़ सकती है। या फिर **manufacturing cost** की कम हो सकती है। जबकि किसी **pure semiconductor** की कोई और **element mix** करें तो उसकी **conductivity**

तेजी से बढ़ती है। **semiconductors** के ये दो **important features** उन्हें **conductors** से ज्यादा **useful** और **special** बनाते हैं।

अब हम **solids** का **classification, energy level** और **energy bands** के **terms** में करेंगे।

हमने पढ़ा हुआ है कि— किसी **atom** के **center** में **+ive nucleus** होता जिसमें **proton** व **neutron** होते हैं तथा **nucleus** के चारों ओर **orbits** में **electron** चक्कर लगाते हैं।

निश्चित पहले **orbit** में **max. 2**, दूसरे में **8** 3<sup>rd</sup> **18** हर **orbit** में **electrons** एक **certain fixed** होती है। जितना बड़ा **orbit** होगा। उसमें **electrons** की उतनी ही अधिक **energy** होगी। यदि किसी **electron** को **lower orbit** से **higher orbit** में **shift** करना हो तो दोनों **orbits** की **energy** में जो **difference** है उतनी **extra energy**, **electron** को देनी पड़ेगी **only then that electron can go the higher energy orbit.** यहां हर **orbit** की **energy** को **energy level** से **represent** करते हैं। इस प्रकार **first orbit** को **1st E.L.**, **second orbit** को **2<sup>nd</sup> E.L.** और तीसरे **orbit** को **3<sup>rd</sup> E.L.** से प्रदर्शित करते हैं।

**So larger the orbit of an electron, greater is its energy and higher is the energy level.**

जब किसी **Solid** की बात करते हैं तो जो पास पास **atoms** होते हैं। यानि **Closely packed neighboring atoms** के एक दूसरे पर

अपना अपना प्रभाव डालते हैं। सभी atoms के first orbit की energies की range को Ist energy band से represent करते हैं।

**Valance Band, conduction band, F.E.G**

**Insulators**            **large gap**  
**Conductors**            **over lapping**  
**Semiconductors**    **V.B. filled**  
                                 **C.B. Empty**

**Si (14)**            **2, 8, 14**

**Ge (32)**            **2, 8, 18, 4**

Si 3<sup>rd</sup> orbit the energy is represented by V.B. and its value 0.7 eV जबकि C.B. की energy 1.8 eV होती है। इसलिये किसी electron V.B. से C.B. तक ले जाने के लिये इन दोनों की energy का Difference यानि कि  $1.8 - 0.7 = 1.1$  eV energy देनी पड़ेगी। यदि 1.1 eV energy Si के लिए F.E.G. energy की होती है।

**Ge (32) : 2, 8, 18, 4 FEG 0.7 eV**

**Intrinsic**            **pure**

**Extrinsic**            **doping**

**Penta valent**            **Arsenic(33) 2, 8, 18, 5**

**Antimony (51)**

**Trivalent**

**Gallium (31) 2, 8, 18, 3**

**Mdium (49)**

**Mr. Sagar Kanujia 8299035074**

**= 29 June 2017 thur. 06:00 PM**

**100.3 FM AIR Kanpur**





**Dr. Sanjay Kr. Sharma**

**Associate Prof.**

**Dept of Phys, D.B.S. College, Kanpur**

**Has been teaching physics since April 1988.**

**Secretary of Indian association of physics teachers  
(AIPT)**

**Managing editor of bulletin of IAPT a monthly journal  
of physics education**

**Founder member of Anveshika in Kanpur where  
teachers and students learn concepts of physics with a  
spirit of “learning by doing”**

**Performed many science shows for the students and  
worked as mentor in INSPIRE programme.**

**Immulate past secretary and of present EC Member of  
IETE “ institution of electronic & telecommunication  
engineers**

**Research field is ultrasonic’s (Two research scholars are  
passing Ph.D.)**